








	<h2 style="color: red;">FDU6N50TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDU6N50TU</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 6A IPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDU6N50TU.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1672 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU6N50TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1672 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 6A (Tc) 89W (Tc) Through Hole I-PAK
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Verlustleistung (max)	89W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	940pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDU6N50TU ist neu im Original, Suche FDU6N50TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU6N50TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU6N50TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU6N50F VB FDU6N50F VB</p>	 <p>FDU7030BL AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A I-PAK</p>	 <p>FDU6N50 FAIRCHI FDU6N50 FAIRCHI</p>	 <p>FDU7N20TM VB FDU7N20TM VB</p>
 <p>FDU6N50TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A IPAK</p>	 <p>FDU7030BL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A I-PAK</p>	 <p>FDU6N50FTU VB FDU6N50FTU VB</p>	 <p>FDU7N60NZ FAIRCHILD FDU7N60NZ FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

12101U180JAT2A	18125C474MAZ2A	B2424LD-1W	D DZ23C2V7	EMZ6.8NTL
FDU044AN03L	FDU044AN03L	D FDU068AN03L	FDU068AN03L	FDU3N40TU
FDU3N40TU	FDU6030BL	FDU6030BL	FDU6512A	FDU6512A
D FDU6530A	FDU6612A	FDU6612A	FDU6630A	FDU6670A
FDU6670AL-NL	FDU6676AS	FDU6676AS	FDU6680A	FDU6680AS
FDU6N20TM	FDU6N50F	D FDU6N50FTU	FDU6N50TU	FDU7030BL
FDU7030BL	D FDU7N20TM	FDU7N60NZTU	FDU7N60NZTU	IMP1232LPSN-2
JS28F320J3D75D	LT1173CS8#TRPBF	MAX964EEE+T	MB15F08SLPFV1-G-BND-6	MB90F345ESPMC-GE1
MP9943AGQ-Z	MTC50150-TB-C2	MUBW1506A7	D NJU7701F02-TE1	SPF-2086TK
SPI-8757-3-5	TL431AQDBZT	TLP3601F	VI-J6T-MX	XC6206P182PR

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited